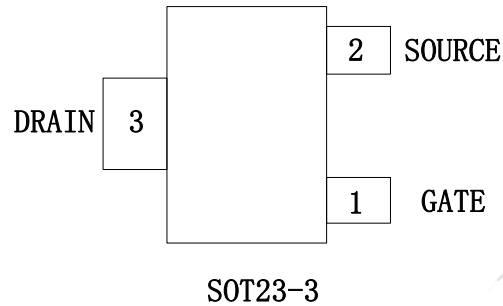


**产品特性:**

- 500V N 沟道 MOSFET
- $R_{ds(on)} = 12\Omega @ V_{gs}=10V$

**应用领域:**

- AC-DC 驱动转换
- LED 驱动

**管脚定义:**

**绝对最大额定值**( $T_J = 25^\circ\text{C}$  除非特别说明):

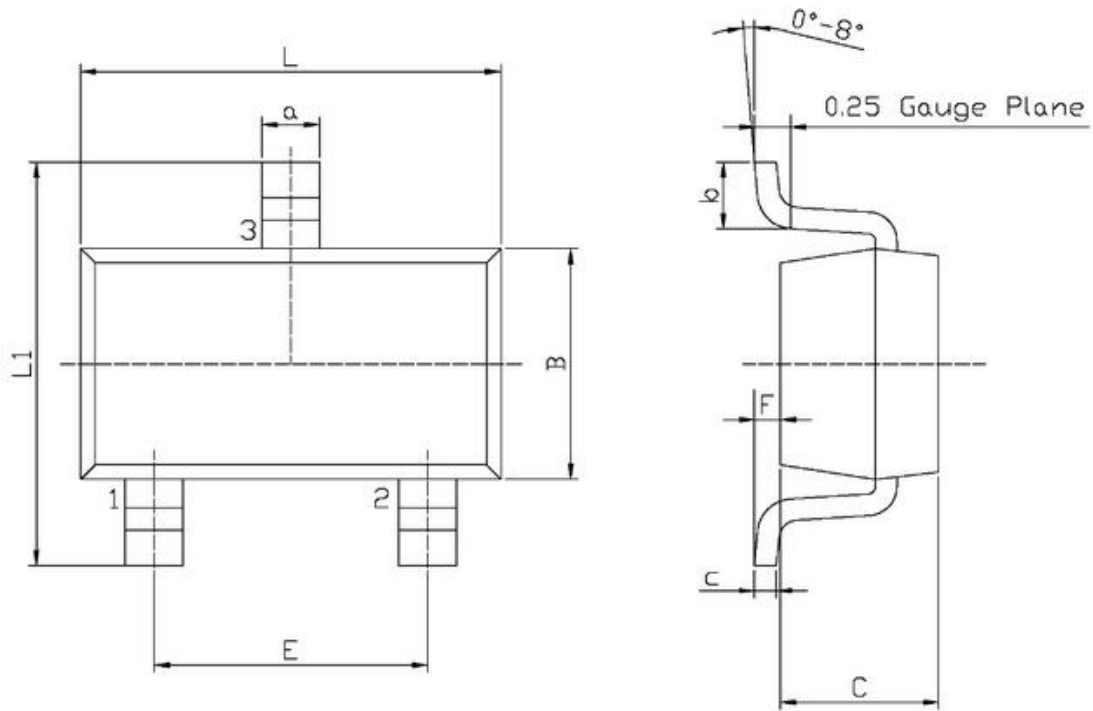
参数	符号	数值	单位
漏源电压	$V_{DS}$	500	V
栅源电压	$V_{GS}$	$\pm 30$	V
工作温度范围	$T_j$	-50 to 150	$^\circ\text{C}$
工作温度范围	$T_{STG}$	-50 to 150	$^\circ\text{C}$

注: 在连续的重负载条件下(例如: 高压, 高电流及高温等条件下)可能引起该产品可靠性降低, 即使使用条件在绝对最大额定值范围内。

**电气特性**( $T_j = 25^\circ\text{C}$ 。除非特别说明)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	$V(BR)_{DSS}$	$V_{GS} = 0V, I_D = 250\mu A$	500	540	-	V
静态漏源导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10V, I_D = 0.4A$	-	12	15	$\Omega$
阈值电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu A$	2	3	4	V
漏源漏电流	$I_{DSS}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = 250\mu A$	-	-	1	$\mu A$
栅源漏电流	$I_{GSS}$	$V_{GS} = 30V$	-	-	100	nA
反向栅源漏电流	$I_{GSSR}$	$V_{GS} = -30V$	-100	-	-	nA
正向压降	$V_{SD}$	$I_S = 1.0A, V_{GS} = 0V$	-	0.95	1.4	nA

封装尺寸: SOT23-3



符号	毫米	
	最小值	最大值
L	2.82	3.02
B	1.50	1.70
C	0.90	1.30
L1	2.60	3.00
E	1.80	2.00
a	0.35	0.50
c	0.10	0.20
b	0.35	0.55
F	0	0.15